

液体原料供給MOCVD装置

MOCVD装置主要性能

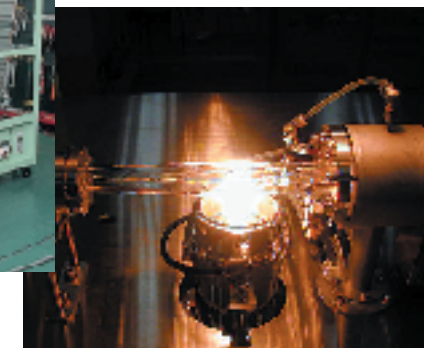
型 式	SV2001/SV3001/SV4001 (SV2003)	SH2001/SH3001/SH4001 (SH2003)	
リアクタ形状	縦型石英リアクタ	横型ステンレスリアクタ	
基板(ウエハ)サイズ×枚数	φ2"×1、φ3"×1、φ4"×1(φ2"×3)	φ2"×1、φ3"×1、φ4"×1(φ2"×3)	
ウエハ面	フェイスアップ	フェイスアップ	
加熱方式	抵抗加熱方式	抵抗加熱方式	
基板回転機構	0~30rpm	0~30rpm	
基板加熱温度(制御用熱電対値)	900℃	1300℃	
プロセス排気	ロータリーポンプ(ドライポンプはオプション対応)	ロータリーポンプ(ドライポンプはオプション対応)	
投入室	排気システム	ターボ分子ポンプ+ロータリーポンプ ※ドライポンプはオプション対応	ターボ分子ポンプ+ロータリーポンプ ※ドライポンプはオプション対応
	基板保管機構(3枚ストック)	標準装備	標準装備
搬送機構		トランスファーロード式またはレール式	トランスファーロード式またはレール式
		有機金属G系統	有機金属G系統
ガス制御ボックス(標準) ※系統数は、お客様のご要望に応じます。		水素化物系3系統	水素化物系3系統
		キャリアガス2系統	キャリアガス2系統
		ベントガス2系統	ベントガス2系統
		ダミーライン	ダミーライン
		パーズライン	パーズライン
シリンダーキャビネット ※系統数は、お客様のご要望に応じます。	47L(10L)容器3本立(ガス3本、窒素1本)	47L(10L)容器3本立(ガス3本、窒素1本)	
制御装置	操作パネル	標準装備	標準装備
	異常表示	標準装備	標準装備
	インターロック機能	標準装備	標準装備
	自動成長システム	標準装備	標準装備
	バックアップ電源	標準装備	標準装備
その他	保安装置 (ガス漏洩、地震、各種異常の検知、警報およびインターロック)	標準装備	標準装備
	窒素精製器	オプション	オプション
	水素精製器	オプション	オプション
	除害装置	オプション	オプション
	In-Situモニタリングシステム	オプション	オプション

酸化物材料開発用として液体原料供給が可能なMOCVD装置を取り揃えております。

MPC1100V



産業技術総合研究所殿納入設備



- リアクタ: 横型石英製
- 基板サイズ: φ1インチ×1枚
- 基板加熱: ランプ加熱方式
- 最高加熱温度: 800℃ (制御用熱電対値)
- 流量制御: 液体マスフローコントローラ
- 気化方式: 熱式気化器
- 適用: 酸化物など

MPC2100H



産業技術総合研究所殿納入設備

- リアクタ: 縦型ステンレス製
- 投入室: トランスファーロード付
- 基板サイズ: φ2インチ×1枚
- 基板加熱: 抵抗加熱方式
- 最高加熱温度: 800℃ (制御用熱電対値)
- 流量制御: 液体マスフローコントローラ
- 気化方式: 熱式気化器
- 適用: 酸化物など

アンモニア除害装置



特徴

アンモニアと水素を高性能触媒により、低い温度(約300℃)で空気中の酸素と反応させて、環境にやさしい水に分解します。小型かつ低ランニングコストです。

仕様

- 処理量: アンモニア 5SLM
水素 20SLM
※処理量はお相談に応じます。
- 排出ガス中濃度: NH₃ 25ppm以下

MPC6100



奈良先端科学技術大学院大学殿納入設備

- リアクタ: 縦型ステンレス製
- 投入室: トランスファーロード付
- 基板サイズ: φ6インチ×1枚
- 基板加熱: 抵抗加熱方式
- 最高加熱温度: 800℃ (制御用熱電対値)
- 流量制御: 液体マスフローコントローラ
- 気化方式: 熱式気化器
- 適用: PZT含む酸化物など